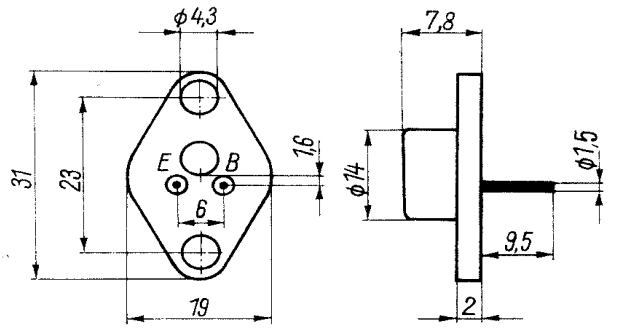


Germanium-pnp-Leistungstransistor der Bauform D nach TGL 11 811 für 48-V-Schalteranwendungen, für Niederfrequenz-Leistungsverstärker und als Pärchen in Gegentaktendstufen bei Spitzenspannungen bis zu 50 V.



Masse ca. 7,5 g

Wärmewiderstand

$R_{thjc} \leq 7,5 \text{ grad/W}$

Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO} = 50 \text{ V}$
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CER} = 48 \text{ V}$
$R_{BE} = 50 \Omega$	
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CES} = 50 \text{ V}$
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO} = 10 \text{ V}$
Gesamtverlustleistung	$P_v = 5,3 \text{ W}$
Kollektorstrom	$-I_c = 3,0 \text{ A}$
Emitterstrom	$I_E = 3,6 \text{ A}$
Basisstrom	$-I_B = 0,6 \text{ A}$
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_1 = +85 \text{ }^\circ\text{C}$
Betriebstemperaturbereich	$-25 \text{ }^\circ\text{C bis } +65 \text{ }^\circ\text{C}$

Statische Kennwerte

		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CBO}$		$20 \mu\text{A}$	$50 \mu\text{A}$
$-U_{CB} = 6 \text{ V}$				
Kollektor-Emitter-Reststrom	$-I_{CES}$		$300 \mu\text{A}$	$1000 \mu\text{A}$
$-U_{CE} = 48 \text{ V}$				
Kollektor-Reststrom bei gesperrter Emitterdiode	$-I_{CEV}$		$100 \mu\text{A}$	$1000 \mu\text{A}$
$-U_{EB} = 1 \text{ V}$				
$-U_{CE} = 20 \text{ V}$				
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$-U_{CEsat}$		$0,3 \text{ V}$	$0,6 \text{ V}$
$-I_B = 0,5 \text{ A}$				
$-I_c = 3 \text{ A}$				
Basis-Emitter-Spannung	$-U_{BE}$		$0,35 \text{ V}$	$0,5 \text{ V}$
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$				
$-I_c = 0,2 \text{ A}$				
Basis-Emitter-Spannung	$-U_{BE}$		$0,75 \text{ V}$	$1,0 \text{ V}$
$-U_{CE} = 2 \text{ V}$				
$-I_c = 1,5 \text{ A}$				
Kollektor-Basis-Stromverhältnis	h_{21E}	18		35
$-U_{CE} = 2 \text{ V}$		28		56
$-I_c = 1,5 \text{ A}$		45		90
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$			30	
$-I_c = 1,5 \text{ A}$				
h_{21E} -Verhältnis	$h_{21E} (0,5 \text{ A})$	$0,5$		
	$h_{21E} (1,5 \text{ A})$			
$-U_{CE} = 2 \text{ V}$				
$-I_c = 1,5 \text{ A}$				
$-I_c = 0,2 \text{ A}$				

Stromverstärkungsgruppe

A
B
C



		Min.	Typ	Max.	
Paarigkeitsbedingungen					
Verhältnis der Basisströme	$\frac{I_{B1}}{I_{B2}}$	0,833		1,2	
bei					
-U _{CE}	= 6 V				
-I _c	= 0,2 A				
und					
-U _{CE}	= 2 V				
-I _c	= 3 A				
Verhältnis der Basis-Emitterspannungen	$\frac{U_{BE1}}{U_{BE2}}$	0,833		1,2	
bei					
-U _{CE}	= 2 V				
-I _c	= 3 A				
Dynamischer Kennwert					Stromverstärkungsgruppe
Übergangsfrequenz	f _T	180 kHz	250 kHz		A
-U _{CE}	= 6 V	220 kHz	300 kHz		B
-I _c	= 0,3 A	250 kHz	350 kHz		C

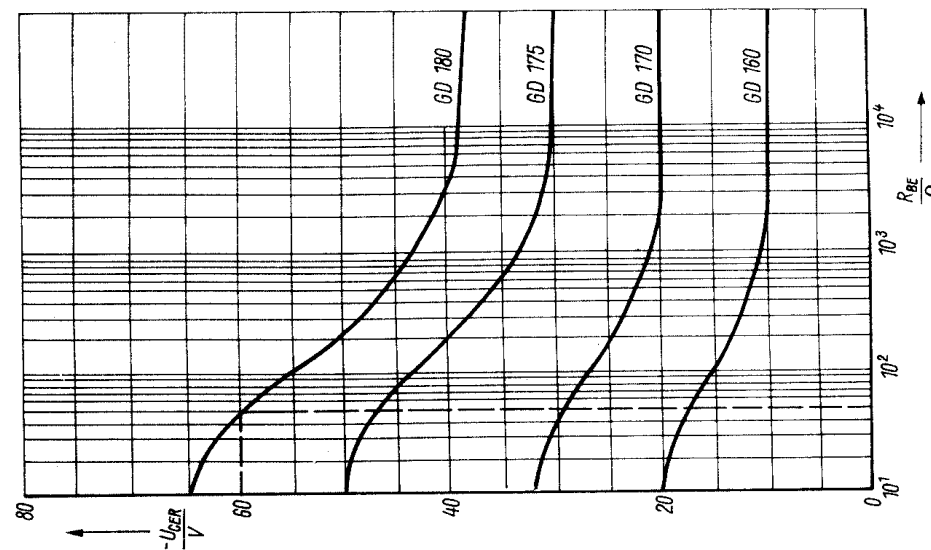
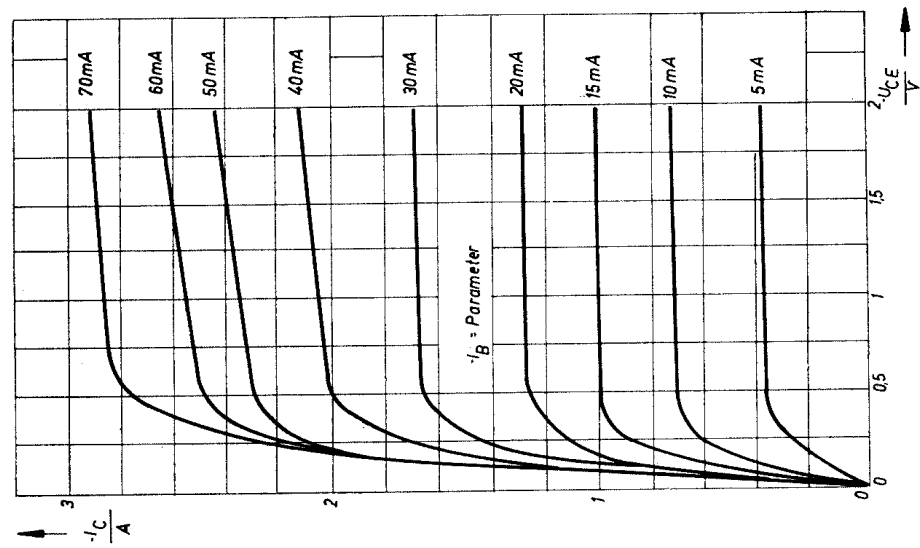
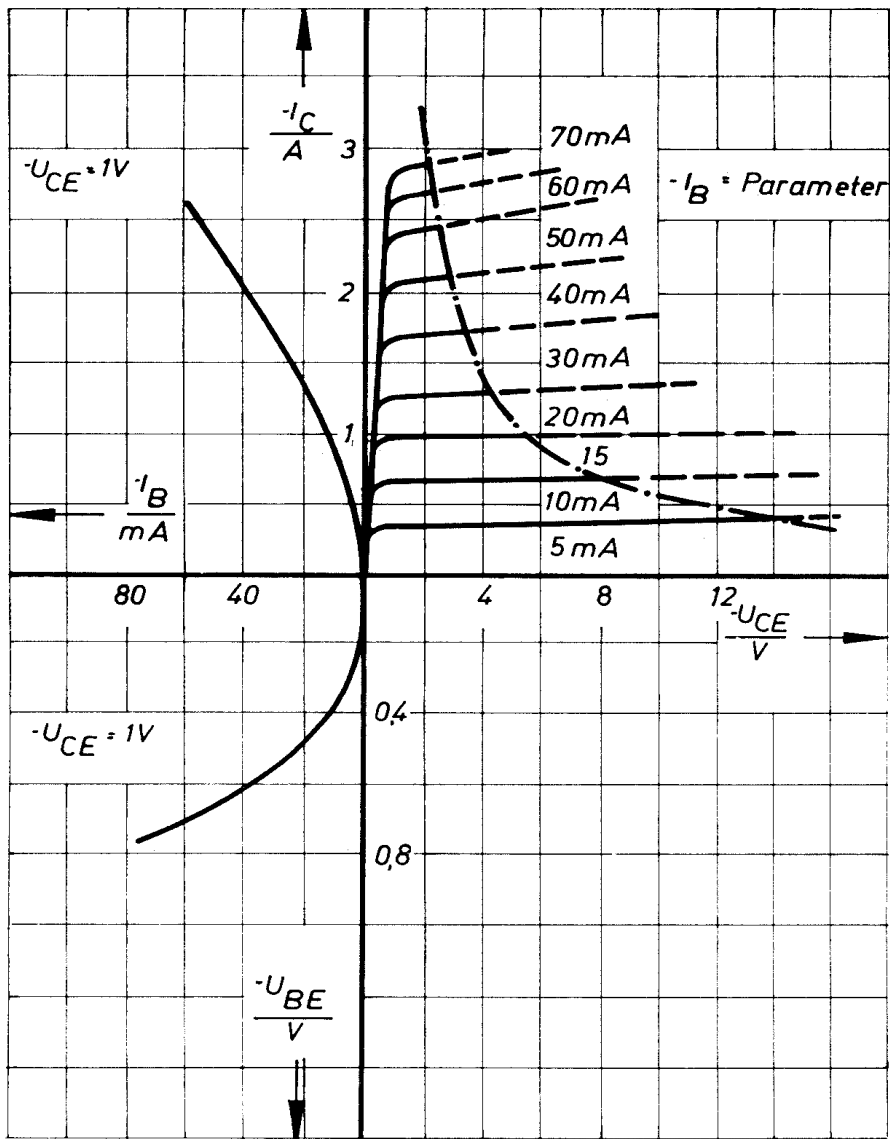
Bestellbeispiel für einen Transistor
der Stromverstärkungsgruppe A

Transistor GD 175 A

Bestellbeispiel für ein Transistorpaar
der Stromverstärkungsgruppe A

Transistorpaar 2 GD 175 A





Kühlfläche Al 2 mm dick, blank, vertikale Lage –
bei isolierter Montage Lackpapier 0,1 mm dick.

- direkte Montage
- - - isolierte Montage
- K = Kühlfläche

